

SRAM Memory Card

PC Card Standard 準拠

製品仕様書

JS64G3-C

JS128G3-C

JS256G3-C-13

JS512G3-C-13

JS1024G3-C-14

JS2048G3-C-14

JS4096G3-C-14

株式会社 
FUJISOKU CORPORATION

システム事業部

〒211-0021 川崎市中原区木月住吉町 1874

電話 044-430-6020 (代)

改版履歴

改 0 版

- ・初版発行

改 1 版 (1998.11)

- ・仕様書の統合

改 2 版 (2002.04)

- ・製品の統廃合により JS1024G3-C-13、JS2048G3-C-13 および増設アトリビュートメモリ付き仕様の全品種を削除。
- ・書式全面変更。

目次

1. 特長	2
2. 品 種	2
3. ヒアサイン	3
4. ヒ名称 機能	4
5. ブロック図	5
6. 絶対最大定格	6
7. 推奨動作条件	6
8. DC 特性	6
8.1 JS64G3-C	6
8.2 JS128G3-C	7
8.3 JS256G3-C-13	7
8.4 JS512G3-C-13	8
8.5 JS1024G3-C-14	8
8.6 JS2048G3-C-14	9
8.7 JS4096G3-C-14	9
9. 入出力容量	10
10. コモンメモリ動作モード	10
10.1 リード動作 (ライトプロテクトスイッチ= プロテクトまたはノンプロテクト)	10
10.2 ライト動作 (ライトプロテクトスイッチ= ノンプロテクト状態)	10
11. AC 特性	11
11.1 条 件	11
11.2 リードタイミング	11
11.3 ライトタイミング	12
12. アトリビュートメモリ	14
12.1 動作モード	14
12.2 リードタイミング	14
13. 電氣的インターフェイス	15
14. 電源投入、切断タイミング	15
15. 電池電圧検知端子モード	16
16. 電池寿命	16
17. ライトプロテクト出力	16
18. 質 量	16
19. カート属性情報	17
20. 外観図	18
21. ご使用に際してのご注意/Attention	19

1. 特長

電源電圧	5V ± 5 % 単一電源
高速アクセス	コモンメモリ 200nsec (MAX) / アトリビュートメモリ 300nsec (MAX)
コネクタ	68 ピン / ツーピース
電池	コイン型リチウム電池 (BR2325 or CR2325)
入出力レベル	入力: TTL レベル / 出力: CMOS レベル
リセット回路内蔵	
書き込み防止スイッチ (プロテクト信号出力付)	

2. 品 種

品 名	デバイス構成	容 量
JS64G3-C	256K bit SRAM × 2 個	64K Byte
JS128G3-C	256K bit SRAM × 4 個	128K Byte
JS256G3-C-13	1M bit SRAM × 2 個	256K Byte
JS512G3-C-13	1M bit SRAM × 4 個	512K Byte
JS1024G3-C-14	4M bit SRAM × 2 個	1024K Byte
JS2048G3-C-14	4M bit SRAM × 4 個	2048K Byte
JS4096G3-C-14	4M bit SRAM × 8 個	4096K Byte

3. ヒアサイン

No.	PC Card 規格		JS シリーズ		Note	No.	PC Card 規格		JS シリーズ		Note
	端子名	I/O	端子名	I/O			端子名	I/O	端子名	I/O	
01	GND		GND			35	GND		GND		
02	D3	I/O	D3	I/O		36	CD1#	O	CD1#	O	
03	D4	I/O	D4	I/O		37	D11	I/O	D11	I/O	
04	D5	I/O	D5	I/O		38	D12	I/O	D12	I/O	
05	D6	I/O	D6	I/O		39	D13	I/O	D13	I/O	
06	D7	I/O	D7	I/O		40	D14	I/O	D14	I/O	
07	CE1#	I	CE1#	I		41	D15	I/O	D15	I/O	
08	A10	I	A10	I		42	CE2#	I	CE2#	I	
09	OE#	I	OE#	I		43	VS1#	O	-		1
10	A11	I	A11	I		44	RFU		-		1
11	A9	I	A9	I		45	RFU		-		1
12	A8	I	A8	I		46	A17	I	A17	I	2
13	A13	I	A13	I		47	A18	I	A18	I	2
14	A14	I	A14	I		48	A19	I	A19	I	2
15	WE#	I	WE#	I		49	A20	I	A20	I	2
16	R/B#	O	-		1	50	A21	I	A21	I	2
17	Vcc		Vcc			51	Vcc		Vcc		
18	Vpp1		-		1	52	Vpp2		-		1
19	A16	I	A16	I	2	53	A22	I	A22	I	1
20	A15	I	A15	I		54	A23	I	A23	I	1
21	A12	I	A12	I		55	A24	I	-		1
22	A7	I	A7	I		56	A25	I	-		1
23	A6	I	A6	I		57	VS2#	O	-		1
24	A5	I	A5	I		58	RESET	I	-		1
25	A4	I	A4	I		59	WAIT	O	-		1
26	A3	I	A3	I		60	RFU		-		1
27	A2	I	A2	I		61	REG#	I	REG#	I	
28	A1	I	A1	I		62	BVD2	O	BVD2	O	
29	A0	I	A0	I		63	BVD1	O	BVD1	O	
30	D0	I/O	D0	I/O		64	D8	I/O	D8	I/O	
31	D1	I/O	D1	I/O		65	D9	I/O	D9	I/O	
32	D2	I/O	D2	I/O		66	D10	I/O	D10	I/O	
33	WP	O	WP	O		67	CD2#	O	CD2#	O	
34	GND		GND			68	GND		GND		

Note)

1: JS シリーズでは未使用となります。(カード内では未接続状態)

2: JS64G3-C: A16 ~ A21 = NC
 JS128G3-C: A17 ~ A21 = NC
 JS256G3-C-13: A18 ~ A21 = NC
 JS512G3-C-13: A19 ~ A21 = NC
 JS1024G3-C-14: A20 ~ A21 = NC
 JS2048G3-C-14: A21 = NC

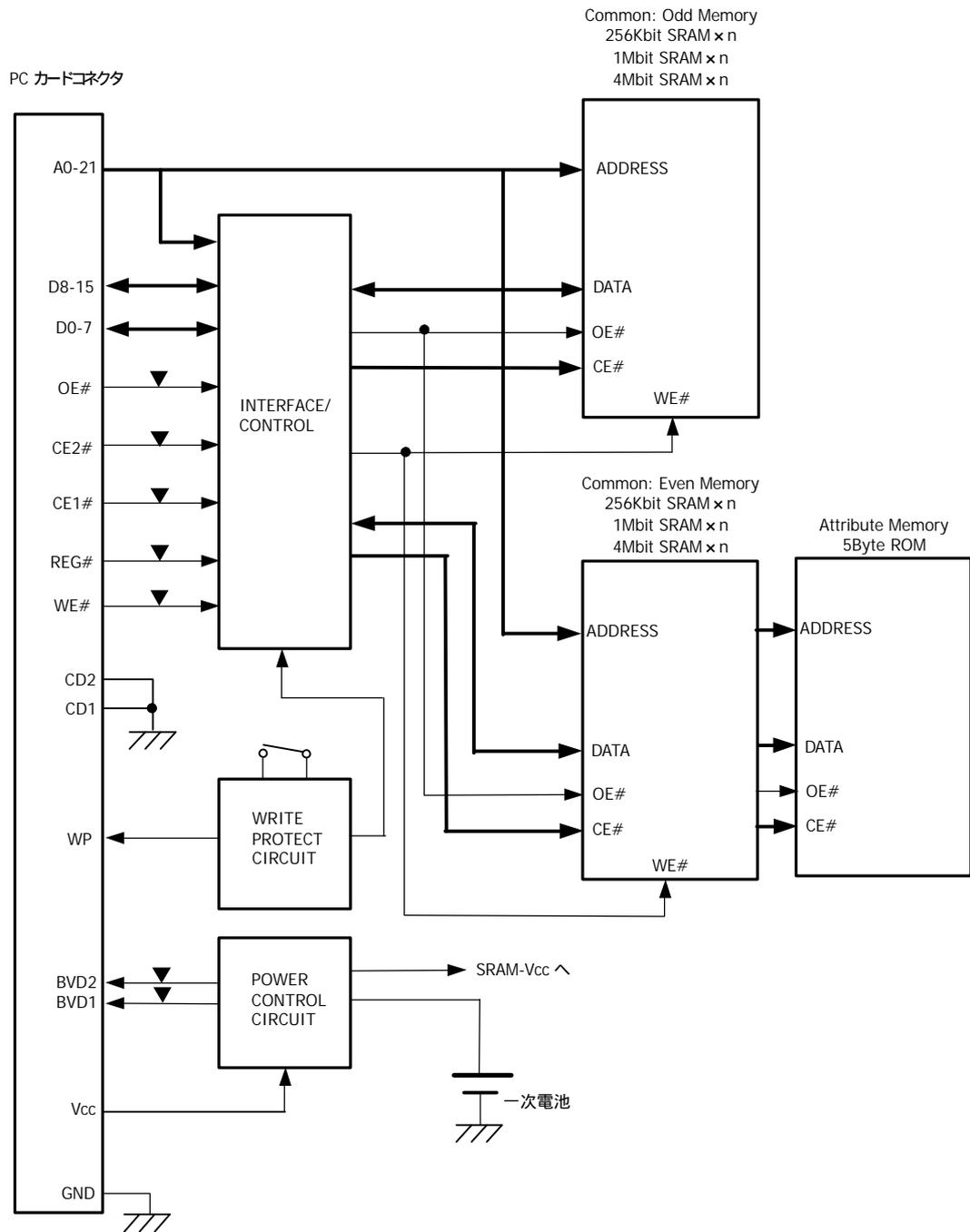
3: “#” 記号はアクティブローを意味します。

4. ピン名称 機能

記号	端子名称	入出力	機能
Vcc	電源電圧		メモカードの電源入力端子
GND	グランド		メモカードのグランドレベル
D0-15	データバス	双方向	双方向データバス
A0-21	アドレスバス	入力	メモカードのアドレス指定
CE1#, CE2#	カードイネーブル1,2	入力	カードイネーブル端子 1, 2
OE#	アウトプットイネーブル	入力	データ読み出し用アクティブロー信号
WE#	ライトイネーブル	入力	データ書き込み用アクティブロー信号
WP	ライトプロテクト	出力	誤書き込み防止スイッチ状態の出力
CD1#, CD2#	カードデテクト1, 2	出力	コネクタ両端に位置するカード挿入検知信号
REG#	アトリビュートメモリセレクト	入力	アトリビュートメモリ選択信号
BVD1, 2	電池電圧検知	出力	電池電圧検知出力
-	ノーコネクション	-	未使用端子(カード内では未接続)

Note) “#” 記号はアクティブローを意味します。

5. ブロック図



▼ :Vcc へプルアップ

6. 絶対最大定格

項目	記号	定 格	単位	備 考
電源電圧	Vcc	-0.3 ~ +7.0	V	
入力電圧	Vin	-0.3 ~ Vcc+0.3	V	
出力電圧	Vout	0 ~ Vcc	V	
動作温度範囲	Topr	0 ~ +60		
動作湿度範囲	Hopr	相対湿度 10 ~ 90 (結露のないこと)	%	電池は除く
保存温度範囲	Tstr	-20 ~ +70		
データ保持温度範囲	Tdr	0 ~ +60		
データ保持湿度範囲	Hdr	相対湿度 10 ~ 90 (結露のないこと)	%	

7. 推奨動作条件

項目	記号	最小	標準	最大	単位
電源電圧	Vcc	4.75	5.0	5.25	V
ハイレベル入力電圧	V _{IH}	2.2		Vcc	V
ローレベル入力電圧	V _{IL}	0		0.8	V
動作温度範囲	Topr	0 ~ +60			
動作湿度範囲	Hopr	相対湿度 : 10 ~ 85			%
保存温度範囲	Tstg	-20 ~ +70			
データ保持温度範囲	Tdr	0 ~ +60			
データ保持湿度範囲	Hdr	相対湿度 : 10 ~ 85			%

8. DC 特性

8.1 JS64G3-C

項目	記号	条 件	最小	最大	単位
入力リーク電流	ILI1	V _{IN} =0 or Vcc, A0-A7	-12	12	μA
	ILI2	V _{IN} =0 or Vcc, A8-A15	-7	7	μA
	ILI3	V _{IN} =0 or Vcc, CE1, 2#, OE#, WE#, REG#	-70	70	
入出力リーク電流	ILD	V _{IN} =0 or Vcc, D0-15	-20	20	μA
電源電流	I _{CC1}	V _{IN} =0 or Vcc, Open outputs CE1# or CE2# = V _{IL} , REG# = V _{IH}		80	mA
	I _{CC2}	V _{IN} =0 or Vcc, Open outputs CE1# = CE2# = V _{IL} , REG# = V _{IH} , f=5MHz		150	mA
スタンバイ電源電流	I _{SB}	V _{IN} =0 or Vcc, REG# = CE1# = CE2# = V _{IH}		490	μA
ハイレベル出力電流	V _{OH}	I _{OH} =0mA	Vcc-0.1		V
	V _{OH}	I _{OH} =-400 μA	Vcc-0.4		V
ローレベル出力電圧	V _{OL}	I _{OL} =0mA		0.1	V
	V _{OL}	I _{OL} =4mA		0.4	V

Note) BVD1,2 は除く

8.2 JS128G3-C

項目	記号	条件	最小	最大	単位
入力リーク電流	ILI1	VIN=0 or Vcc, A0-A7	-14	14	μA
	ILI2	VIN=0 or Vcc, A8-A16	-9	9	μA
	ILI3	VIN=0 or Vcc, CE1, 2#, OE#, WE#, REG#	-70	70	
入出力リーク電流	ILD	VIN=0 or Vcc, D0-15	-20	20	μA
電源電流	Icc1	VIN=0 or Vcc, Open outputs CE1#orCE2#=VIL, REG#=VIH		80	mA
	Icc2	VIN=0 or Vcc, Open outputs CE1#=CE2#=VIL, REG#=VIH, f=5MHz		150	mA
スタンバイ電源電流	ISB	VIN=0 or Vcc, REG#=CE1#=CE2#=VIH		530	μA
ハイレベル出力電流	VOH	IOH=0mA	Vcc-0.1		V
	VOH	IOH=-400 μA	Vcc-0.4		V
ローレベル出力電圧	VOL	IOL=0mA		0.1	V
	VOL	IOL=4mA		0.4	V

Note) BVD1,2 は除く

8.3 JS256G3-C-13

項目	記号	条件	最小	最大	単位
入力リーク電流	ILI1	VIN=0 or Vcc, A0-A7	-12	12	μA
	ILI2	VIN=0 or Vcc, A8-A17	-7	7	μA
	ILI3	VIN=0 or Vcc, CE1, 2#, OE#, WE#, REG#	-70	70	
入出力リーク電流	ILD	VIN=0 or Vcc, D0-15	-20	20	μA
電源電流	Icc1	VIN=0 or Vcc, Open outputs CE1#orCE2#=VIL, REG#=VIH		110	mA
	Icc2	VIN=0 or Vcc, Open outputs CE1#=CE2#=VIL, REG#=VIH, f=5MHz		210	mA
スタンバイ電源電流	ISB	VIN=0 or Vcc, REG#=CE1#=CE2#=VIH		490	μA
ハイレベル出力電流	VOH	IOH=0mA	Vcc-0.1		V
	VOH	IOH=-400 μA	Vcc-0.4		V
ローレベル出力電圧	VOL	IOL=0mA		0.1	V
	VOL	IOL=4mA		0.4	V

Note) BVD1,2 は除く

8.4 JS512G3-C-13

項目	記号	条件	最小	最大	単位
入力リーク電流	ILI1	VIN=0 or Vcc, A0-A7	-14	14	μA
	ILI2	VIN=0 or Vcc, A8-A18	-9	9	μA
	ILI3	VIN=0 or Vcc, CE1, 2#, OE#, WE#, REG#	-70	70	
入出力リーク電流	ILD	VIN=0 or Vcc, D0-15	-20	20	μA
電源電流	Icc1	VIN=0 or Vcc, Open outputs CE1#orCE2#=VIL, REG#=VIH		110	mA
	Icc2	VIN=0 or Vcc, Open outputs CE1#=CE2#=VIL, REG#=VIH, f=5MHz		210	mA
スタンバイ電源電流	ISB	VIN=0 or Vcc, REG#=CE1#=CE2#=VIH		530	μA
ハイレベル出力電流	VOH	IOH=0mA	Vcc-0.1		V
	VOH	IOH=-400 μA	Vcc-0.4		V
ローレベル出力電圧	VOL	IOL=0mA		0.1	V
	VOL	IOL=4mA		0.4	V

Note) BVD1,2 は除く

8.5 JS1024G3-C-14

項目	記号	条件	最小	最大	単位
入力リーク電流	ILI1	VIN=0 or Vcc, A0-A7	-12	12	μA
	ILI2	VIN=0 or Vcc, A8-A19	-7	7	μA
	ILI3	VIN=0 or Vcc, CE1, 2#, OE#, WE#, REG#	-70	70	
入出力リーク電流	ILD	VIN=0 or Vcc, D0-15	-20	20	μA
電源電流	Icc1	VIN=0 or Vcc, Open outputs CE1#orCE2#=VIL, REG#=VIH		140	mA
	Icc2	VIN=0 or Vcc, Open outputs CE1#=CE2#=VIL, REG#=VIH, f=5MHz		240	mA
スタンバイ電源電流	ISB	VIN=0 or Vcc, REG#=CE1#=CE2#=VIH		490	μA
ハイレベル出力電流	VOH	IOH=0mA	Vcc-0.1		V
	VOH	IOH=-400 μA	Vcc-0.4		V
ローレベル出力電圧	VOL	IOL=0mA		0.1	V
	VOL	IOL=4mA		0.4	V

Note) BVD1,2 は除く

8.6 JS2048G3-C-14

項目	記号	条件	最小	最大	単位
入力リーク電流	ILI1	VIN=0 or Vcc, A0-A7	-14	14	μA
	ILI2	VIN=0 or Vcc, A8-A20	-9	9	μA
	ILI3	VIN=0 or Vcc, CE1, 2#, OE#, WE#, REG#	-70	70	
入出力リーク電流	ILD	VIN=0 or Vcc, D0-15	-20	20	μA
電源電流	Icc1	VIN=0 or Vcc, Open outputs CE1#orCE2#=VIL, REG#=VIH		140	mA
	Icc2	VIN=0 or Vcc, Open outputs CE1#=CE2#=VIL, REG#=VIH, f=5MHz		240	mA
スタンバイ電源電流	ISB	VIN=0 or Vcc, REG#=CE1#=CE2#=VIH		530	μA
ハイレベル出力電流	VOH	IOH=0mA	Vcc-0.1		V
	VOH	IOH=-400 μA	Vcc-0.4		V
ローレベル出力電圧	VOL	IOL=0mA		0.1	V
	VOL	IOL=4mA		0.4	V

Note) BVD1,2 は除く

8.7 JS4096G3-C-14

項目	記号	条件	最小	最大	単位
入力リーク電流	ILI1	VIN=0 or Vcc, A0-A7	-18	18	μA
	ILI2	VIN=0 or Vcc, A8-A21	-13	13	μA
	ILI3	VIN=0 or Vcc, CE1, 2#, OE#, WE#, REG#	-70	70	
入出力リーク電流	ILD	VIN=0 or Vcc, D0-15	-20	20	μA
電源電流	Icc1	VIN=0 or Vcc, Open outputs CE1#orCE2#=VIL, REG#=VIH		140	mA
	Icc2	VIN=0 or Vcc, Open outputs CE1#=CE2#=VIL, REG#=VIH, f=5MHz		240	mA
スタンバイ電源電流	ISB	VIN=0 or Vcc, REG#=CE1#=CE2#=VIH		610	μA
ハイレベル出力電流	VOH	IOH=0mA	Vcc-0.1		V
	VOH	IOH=-400 μA	Vcc-0.4		V
ローレベル出力電圧	VOL	IOL=0mA		0.1	V
	VOL	IOL=4mA		0.4	V

Note) BVD1,2 は除く

9. 入出力容量

条件 : $T_a=25$ 、 $f=1\text{MHz}$ 。全品種共通

項目	記号	条件	最小	最大	単位
入出力容量	C I/O	$V_{IN}=V_{OUT}=0V$		35	pF
入力容量	C IN	$V_{IN}=0V$		110	pF

10. コモンメモリ動作モード

10.1 リード動作 (ライトプロテクトスイッチ= プロテクトまたはノンプロテクト)

モード	REG#	CE2#	CE1#	A 0	OE#	WE#	D8-15	D0-7	WP
スタンバイモード	x	H	H	x	x	x	High-Z	High-Z	L or H
バイトリード	H	H	L	L	L	H	High-Z	偶数バイト	L or H
	H	H	L	H	L	H	High-Z	奇数バイト	
ワードリード	H	L	L	x	L	H	奇数バイト	偶数バイト	L or H
奇数バイトリード	H	L	H	x	L	H	奇数バイト	High-Z	L or H

Note) L= V_{IL} 、H= V_{IH} 、x = V_{IL} or V_{IH}

10.2 ライト動作 (ライトプロテクトスイッチ= ノンプロテクト状態)

モード	REG#	CE2#	CE1#	A 0	OE#	WE#	D8-15	D0-7	WP
スタンバイモード	x	H	H	x	x	x	High-Z	High-Z	L or H
バイトライト	H	H	L	L	H	L	Don't Care	偶数バイト	L
	H	H	L	H	H	L	Don't Care	奇数バイト	
ワードライト	H	L	L	x	H	L	奇数バイト	偶数バイト	L
奇数バイトライト	H	L	H	x	H	L	奇数バイト	Don't Care	L

Note) L= V_{IL} 、H= V_{IH} 、x = V_{IL} or V_{IH}

11. AC 特性

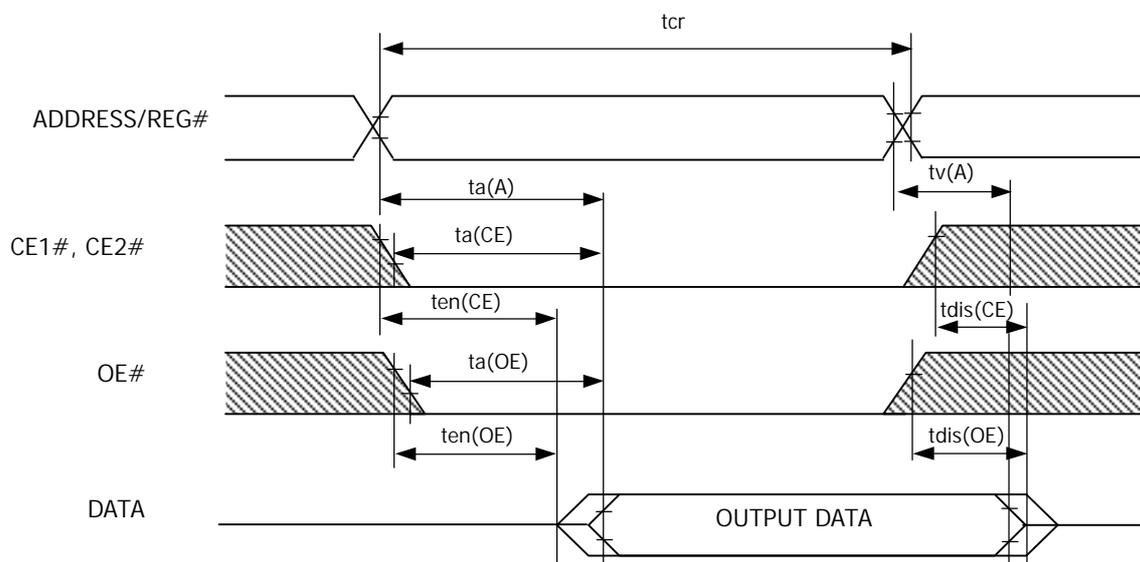
11.1 条件

条件 (推奨動作特性)

・入力パルス電圧レベル	-----	0.4 ~ 2.6V
・入力立ち上がり 立ち下がり時間	-----	10 nsec
・入力 出力タイミングレベル	-----	1.5V
・出力負荷	-----	1TTL+100pF

11.2 リードタイミング

項目	記号	最小	最大	単位
リードサイクル時間	tcr	200		ns
アドレスアクセス時間	ta (A)		200	ns
CE# アクセス時間	ta (CE)		200	ns
OE# アクセス時間	ta (OE)		100	ns
出力ディセーブル時間 (CE#)	tdis (CE)		90	ns
出力ディセーブル時間 (OE#)	tdis (OE)		90	ns
出力イネーブル時間 (CE#)	ten (CE)	5		ns
出力イネーブル時間 (OE#)	ten (OE)	5		ns
データ有効時間 (Address)	tv (A)	0		ns

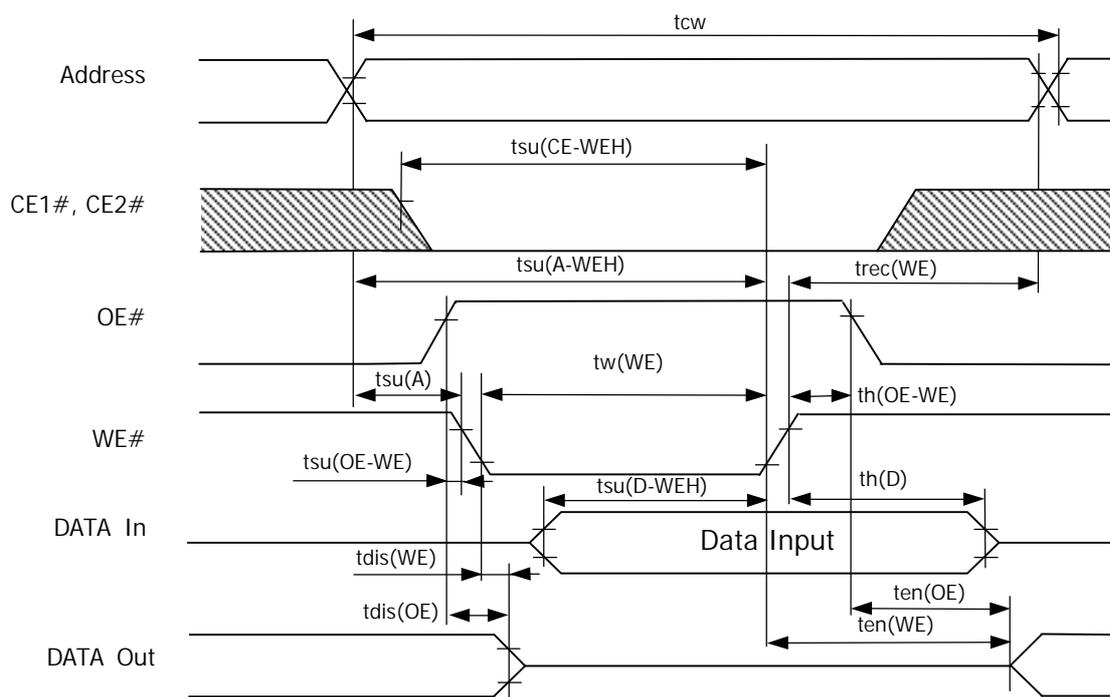


Note) 斜線部は V_{IL} or V_{IH}

図 11.1 リードサイクルタイミング

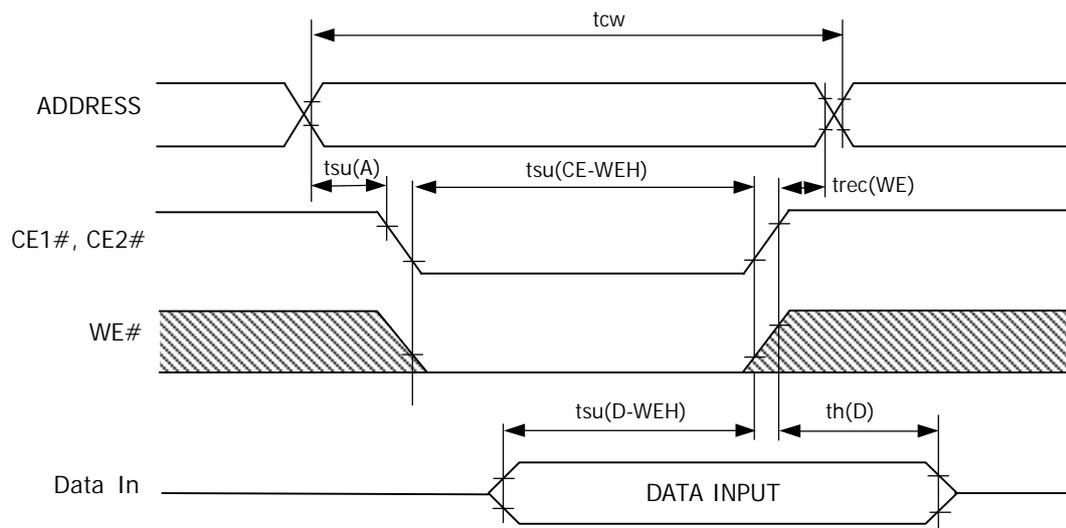
11.3 ライトタイミング

項目	記号	最小	最大	単位
サイクル時間	tcw	200		ns
ライトパルス幅	Tw (WE)	120		ns
アドレスセットアップ時間	tsu (A)	0		ns
アドレスセットアップ時間 (WE#)	tsu (A-WEH)	140		ns
CE# セットアップ時間	tsu (CE-WEH)	140		ns
データセットアップ時間	tsu (D-WEH)	60		ns
データホールド時間	Th (D)	5		ns
ライトカバー時間	trec (WE)	30		ns
出力ディセーブル時間 (WE#)	tdis (WE)		90	ns
出力ディセーブル時間 (OE#)	tdis (OE)		90	ns
出カインーブル時間 (WE#)	ten (WE)	5		ns
出カインーブル時間 (OE#)	ten (OE)	5		ns
OE# セットアップ時間	tsu (OE-WE)	10		ns
OE# ホールド時間	Th (OE-WE)	10		ns



Note) 斜線部は V_{IL} or V_{IH}

図 11.2 ライトサイクルタイミング (WE# コントロール)



Note) 斜線部は V_{IL} or V_{IH}

図 11.3 ライトサイクルタイミング (CE# コントロール)

12. アトリビュートメモリ

アトリビュートメモリには、メモリカード属性情報が存在します。

メモリカード属性情報は、カードの持つ属性を表すもので、アトリビュートメモリの偶数番地(D0-D7)に置かれています。

12.1 動作モード

モード	REG#	CE2#	CE1#	A 0	OE#	WE#	D8-15	D0-7
スタンバイモード	x	H	H	x	x	x	High-Z	High-Z
バイトリード	L	H	L	L	L	H	High-Z	偶数バイト
	L	H	L	H	L	H	High-Z	無効
ワードリード	L	L	L	x	L	H	無効	偶数バイト
奇数バイトリード	L	L	H	x	L	H	無効	High-Z

Note) L = V_{IL}, H = V_{IH}, x = V_{IL} or V_{IH}

12.2 リードタイミング

項目	記号	最小	最大	単位
リードサイクル時間	tcr	300		ns
アドレスアクセス時間	ta (A)		300	ns
CE# アクセス時間	ta (CE)		300	ns
OE# アクセス時間	ta (OE)		150	ns
出力ディセーブル時間 (CE#)	t _{dis} (CE)		100	ns
出力ディセーブル時間 (OE#)	t _{dis} (OE)		100	ns
出力イネーブル時間 (CE#)	t _{en} (CE)	5		ns
出力イネーブル時間 (OE#)	t _{en} (OE)	5		ns
データ有効時間 (Address)	t _v (A)	0		ns

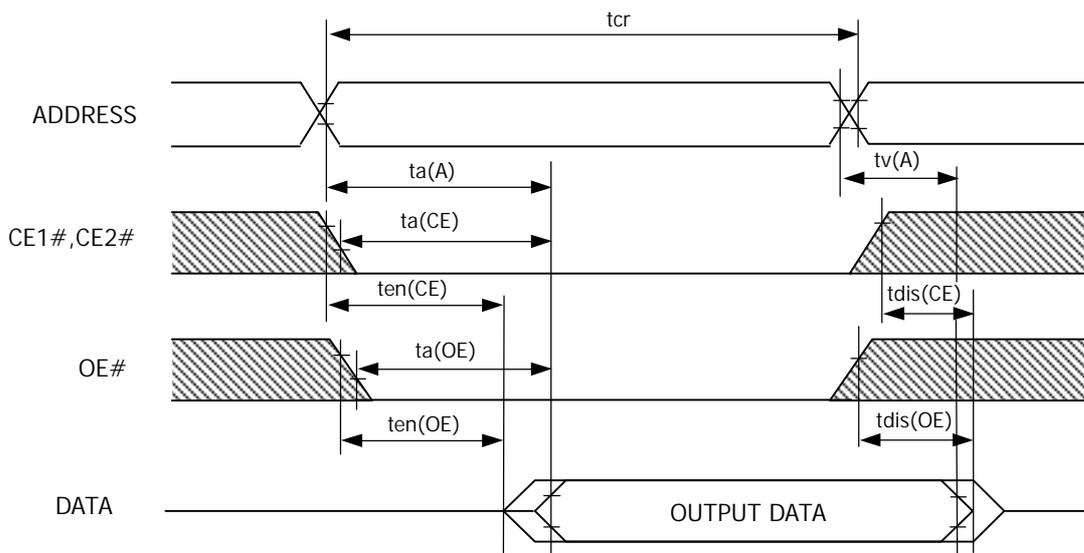


図 12.1 リードタイミング

13. 電氣的インターフェイス

項目	記号	出力形式	カード
コントロール信号	CE1#, CE2#, WE#, OE#, REG#		カード内 100K プリアップ
カード検出	CD1#, CD2#	L	カード内でGNDに接続
ライトプロテクト	WP	H 又は L	
電池電圧検出	BVD1, BVD2	H	カード内で10K プリアップ オープンコレクタ出力

Note) L=VoL, H=VoH

14. 電源投入、切断タイミング

項目	記号	条件	最小	最大	単位
CE#電位	Vi (CE)	0V $V_{CC} < 2V$	0	V_{CC}	V
		2.0 $V_{CC} < V_{IH}$	$V_{CC}-0.1$	V_{CC}	V
		V_{IH} V_{CC}	V_{IH}	V_{CC}	V
CE#セットアップ時間	tsu (CE)		20		ms
CE#リカバリー時間	trec (CE)		0.001		ms
Vcc 立ち上がり時間	tpr	10% ($V_{CC}+5\%$) の90% 90% of ($V_{CC}+5\%$)	0.1	300	ms
Vcc 立ち下がり時間	tpf	($V_{CC}+5\%$) の90% 10% 90% of ($V_{CC}+5\%$)	3.0	300	ms

Note) tpr, tpf は、10%、90%で、直線で変化する。

波形が直線でない場合は、波形の最大傾斜が、上記規格を満たすものとする。

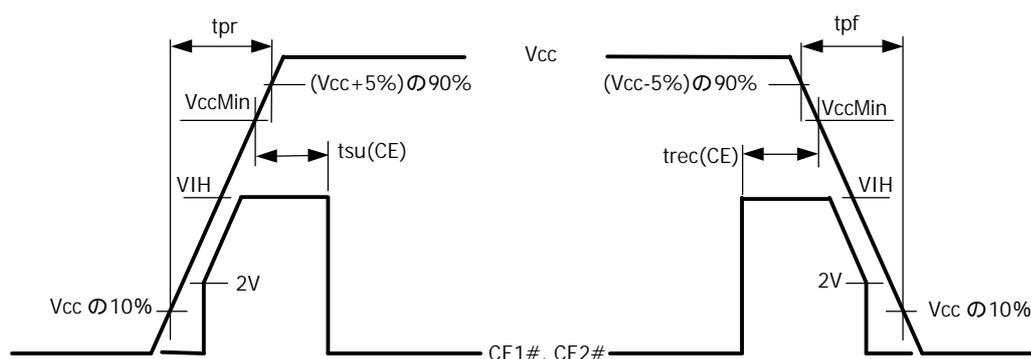


図 14.1 電源投入、切断タイミング

15. 電池電圧検知端子モード

BVD1	BVD2	電池状態	検知電圧
H	H	データを保持するための十分な電池電圧です。	Battery 電圧 > $2.5 \pm 0.1V$
H	L	データは保持しますが、電池交換時期です。	$2.5 \pm 0.1V$ Battery 電圧 > $2.35 \pm 0.1V$
L	x	データ保持は保証されません。	$2.35 \pm 0.1V$ Battery 電圧

Note) Ta = 25 。 L=VOL、H=VOH、x = VOL or VOH。

16. 電池寿命

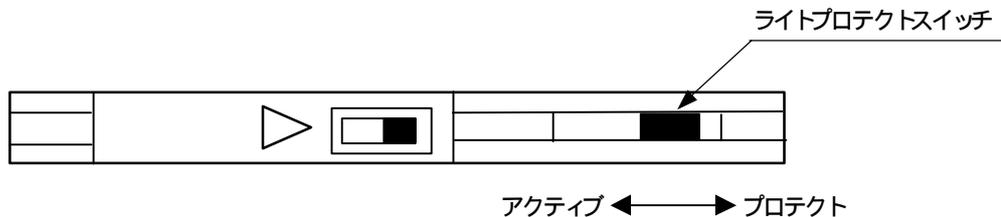
JS64G3-C	JS128G3-C	JS256G3-C-13	JS512G3-C-13	JS1024G3-C-14	JS2048G3-C-14	JS4096G3-C-14
5年以上	5年以上	5年以上	4.4年以上	5年以上	4.4年以上	2.2年以上

Note) Ta = 25

17. ライトプロテクト出力

スイッチ状態	WP	状態
プロテクト	H	書き込み不可
アクティブ	L	書き込み可

Note) L=VOL、H=VOH



18. 質量

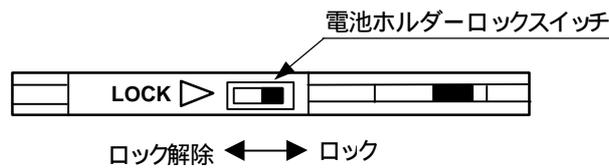
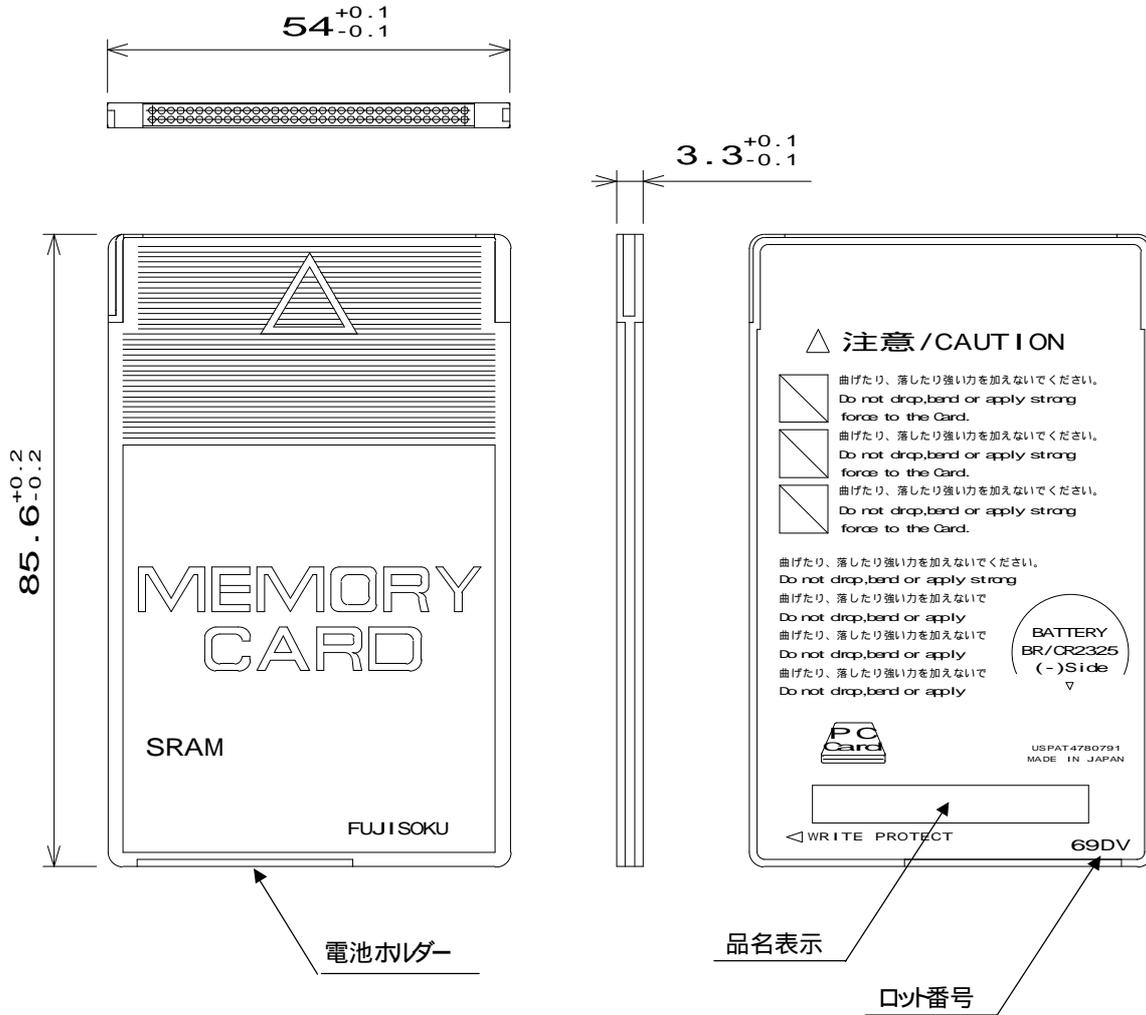
カート質量 40g (MAX)

19. カート属性情報

本シリーズでは、アトリビュートメモリ領域に下記内容のカード属性情報が書き込まれています。
データ内容の詳細は、JEITA 及びPCMCIA から発行されているガイドラインを参照願います。

アドレス	データ	内 容
0000H	01h	コモンメモリデバイス情報タブ
0002H	FFh	次のタブへのポインタ
0004H	62h	SRAM/書き込み禁止無効フラグ/200ns
0006H	左記	メモ容量 JS64G3-C: 0Bh JS128G3-C: 1Bh JS256G3-C-13: 3Bh JS512G3-C-13: 7Bh JS1024G3-C-14: 3Ch JS2048G3-C-14: 7Ch JS4096G3-C-14: FCh
0008H	FFH	タブの終了

20. 外観図



電池ホルダーロックスイッチ操作 (カード後面)

21. ご使用に際してのご注意/Attention

弊社メモリカード製品は、OA 機器、計測機器、FA システム機器などの一般システム機器に使用することを推奨しておりますが、これらの用途以外の特殊な環境下でご使用になられる場合、弊社窓口へ必ずご相談願います。また、弊社メモリカード製品は生命の維持、金銭の取引などのデータを扱う用途を目的としたものではありません。

特殊用途例) 防火・防犯システム、車両搭載システム、車両運行制御システム、燃焼制御システム
航空宇宙システム、核エネルギー制御システムなど

なお、製品の取り扱いについては以下の内容を考慮した上でご使用願います。
製品の破損、データの破損などを引き起こす恐れがあります。

- 1) アルコールなどの薬品で製品を拭かないで下さい。
- 2) パネルの剥がれなどをまねき、思わぬけがをすることがあります。
- 3) 製品を曲げたり、落したり、強い衝撃を与えないでください。
- 4) 重いものを乗せたり、腰のポケットに入れたりして、強い力を加えないでください。
- 5) 水をかけたり、直射日光に直接さらさないでください。
- 6) 製品を分解したり、端子部にクリップなどの金属類を差し込まないでください。
- 7) SRAM カードに付属しているリチウム電池の取り扱いに関しては、次の内容に注意してください。
 - ・電池単体で放置する場合は、幼児の手の届かないところに置いてください。
 - ・万一飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してください。
- 8) 電池を装着する場合は、プラス(+)、マイナス(-)を十分確認した上で挿入してください。
- 9) 付属または指定の電池以外は使用しないでください。
- 10) 未使用時には付属のケースに入れて保管してください。

製品の保証は納入後 1 年とし、この期間内に万一製造上の原因による不良が生じた場合、解析の上、修理もしくは同等品との交換をいたしますが、データ内容の保証についてはご容赦願います。

本製品は 外国為替及び外国貿易管理法」の規定により戦略物資等 (または役務) に該当する場合、日本国外への輸出は日本国政府の輸出許可が必要です。

This card is recommended for use for general system such as OA- system, Measuring-system, FA- system and the like.

You are requested to contact our sales people when you want to use the Card under such particular environments as exemplified below.

This card is not for treating data of life maintenance or money exchange, etc.

[Examples] Fire prevention / Security system, Mobile / Traffic control system, Combustion control system, Aircraft / Spacecraft control system, Nuclear energy control system, etc.

When using the card, follow the below- mentioned instructions.
Otherwise, the card or the data damage may occur.

1. Do not clean the card with such volatile chemicals as alcohol and the like.
Panels may come off from the card and may cause unexpected injury.
2. Do not drop, bend, or apply strong shock to the card.
3. Do not apply strong force to the card by putting it in a pocket of trousers, putting something heavy on the card, or by some other ways.
4. Keep the card free from the water. Do not expose the card under the rays of the sun.
5. Do not disassemble the panels or insert a metal tip such as a pin into the card.
6. Keep away the battery from infants.
In case that they swallow the battery by accident, contact with a doctor as soon as possible.
7. Check the (+), (-) polarity, when replacing the battery.
8. Do not use the battery other than the attached or specified one.
9. Keep the card in the attached case when it is not used.

This card is guaranteed for 1 year after shipment.

If the card is found defective, during the warranty period, due to some cause in manufacturing, it shall be repaired or replaced.

But the stored data is out of warranty.

These products contain Strategic Products subject to COCOM regulations.

They should not be exported without authorization from the Japanese governmental authorities.